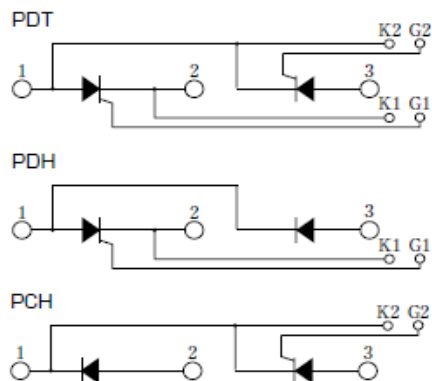


THYRISTOR

100A Avg 1600 Volts

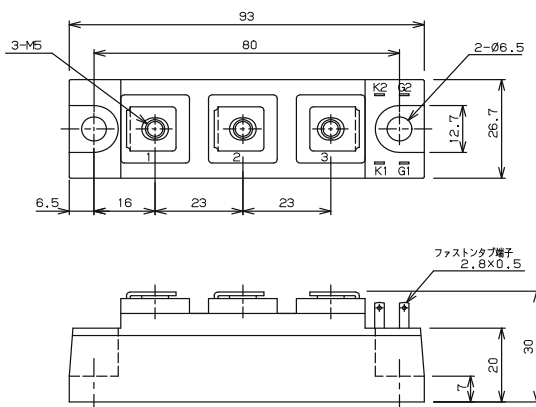
PDT10016
PDH10016
PCH10016

■回路図 CIRCUIT



■外形寸法図 OUTLINE DRAWING

Dimension: [mm]



■最大定格 Maximum Ratings

項目 Parameter	記号 Symbol	耐圧クラス Grade	単位 Unit
		PDT10016/PDH10016/PCH10016	
くり返しピークオフ電圧 Repetitive Peak Off-State Voltage	V_{DRM}	1600	V
非くり返しピークオフ電圧 Non Repetitive Peak Off-State Voltage	V_{DSM}	1700	V
くり返しピーク逆電圧 Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RRM}	1600	V
非くり返しピーク逆電圧 Non Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RSM}	1700	V

項 目 Parameter		記 号 Symbol	条 件 Conditions		定格値 Max.Rated Value	単位 Unit
平均オン電流 Average On-State Current		$I_{O(AV)}$	商用周波数 180° 通電 $T_c=77^{\circ}C$ Half Sine Wave		100	A
実効オン電流 RMS On-State Current		I_{TRMS}			156	A
サージオン電流 Surge On-State Current		I_{TSM}	50Hz 正弦半波, 1 サイクル, 非くり返し Half Sine Wave, 1Pulse, Non-Repetitive		2000	A
電流二乗時間積 I Squared t		I^2t	2～10ms		20000	A ² s
臨界オン電流上昇率 Critical Rate of Rise of Turned-On Current		di/dt	$V_D=2/3 V_{DRM}$, $I_{TM}=2 \cdot I_O$, $T_J=125^{\circ}C$ $I_G=200mA$, $di_G/dt=0.2A/\mu s$		100	A/ μs
ピークゲート電力損失 Peak Gate Power		P_{GM}			5	W
平均ゲート電力損失 Average Gate Power		$P_{G(AV)}$			1	W
ピークゲート電流 Peak Gate Current		I_{GM}			2	A
ピークゲート電圧 Peak Gate Voltage		V_{GM}			10	V
ピークゲート逆電圧 Peak Gate Reverse Voltage		V_{RGM}			5	V
動作接合温度範囲 Operating Junction Temperature Range		T_{Jw}			-40 ～ +125	℃
保存温度範囲 Storage Temperature Range		T_{stg}			-40 ～ +125	℃
絶縁耐圧 Isolation Voltage		Viso	端子—ベース間, AC 1 分間 Terminal to Base, AC 1min.		2500	V
締付トルク Mounting Torque	ベース部 Mounting	F	サマロコンパウンド 塗布 Greased	M6	2.4 ～ 3.5	N・m
	主端子部 Terminal			M5	2.4 ～ 2.8	N・m

■電気的特性 Electrical Characteristics

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	特性値 (最大) Maximum Value			単位 Unit
			最小 Min.	標準 Typ.	最大 Max.	
ピークオフ電流 Peak Off-State Current	I_{DM}	$T_j=125^{\circ}\text{C}$, $V_{DM}=V_{DRM}$			20	mA
ピーク逆電流 Peak Reverse Current	I_{RM}	$T_j=125^{\circ}\text{C}$, $V_{RM}=V_{RRM}$			20	mA
ピークオン電圧 Peak On-State Voltage	V_{TM}	$T_j=25^{\circ}\text{C}$, $I_{TM}=300\text{A}$			1.38	V
トリガゲート電流 Gate Current to Trigger	I_{GT}	$V_D=6\text{V}$, $I_T=1\text{A}$	$T_j=-40^{\circ}\text{C}$		200	mA
			$T_j=25^{\circ}\text{C}$		100	mA
			$T_j=125^{\circ}\text{C}$		50	mA
			$T_j=-40^{\circ}\text{C}$		4	V
トリガゲート電圧 Gate Voltage to Trigger	V_{GT}	$V_D=6\text{V}$, $I_T=1\text{A}$	$T_j=25^{\circ}\text{C}$		2.5	V
			$T_j=125^{\circ}\text{C}$		2	V
非トリガゲート電圧 Gate Non-Trigger Voltage	V_{GD}	$T_j=125^{\circ}\text{C}$, $V_D=2/3V_{DRM}$	0.25			V
臨界オフ電圧上昇率 Critical Rate of Rise of Off-State Voltage	dv/dt	$T_j=125^{\circ}\text{C}$, $V_D=2/3V_{DRM}$	500			V/ μs
ターンオフ時間 Turn-Off Time	t_q	$T_j=125^{\circ}\text{C}$, $I_{TM}=I_o$, $V_D=2/3V_{DRM}$ $dv/dt=20\text{V}/\mu\text{s}$, $V_R=100\text{V}$, $-di/dt=20\text{A}/\mu\text{s}$		100		μs
ターンオン時間 Turn-On Time	t_{gt}			6		μs
遅れ時間 Delay Time	t_d	$T_j=25^{\circ}\text{C}$, $V_D=2/3V_{DRM}$ $I_G=200\text{mA}$, $di/dt=0.2\text{A}/\mu\text{s}$		2		μs
立上がり時間 Rise Time	t_r			4		μs
ラッチング電流 Latching Current	I_L	$T_j=25^{\circ}\text{C}$		100		mA
保持電流 Holding Current	I_H	$T_j=25^{\circ}\text{C}$		50		mA
熱抵抗 Thermal Resistance	$R_{th(j-c)}$	接合部-ケース間 Junction to Case			0.35	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
接触熱抵抗 Thermal Resistance	$R_{th(c-f)}$	ケース-フィン間, サーマルコンパウンド塗布 Case to Fin, Greased			0.2	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$

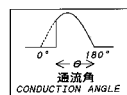
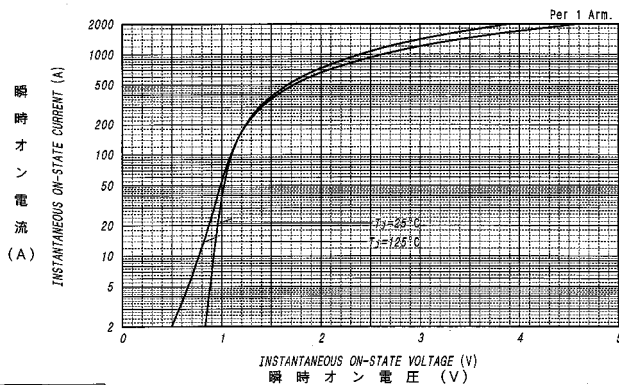
質量…約155g

Approximate Weight

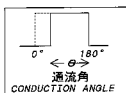
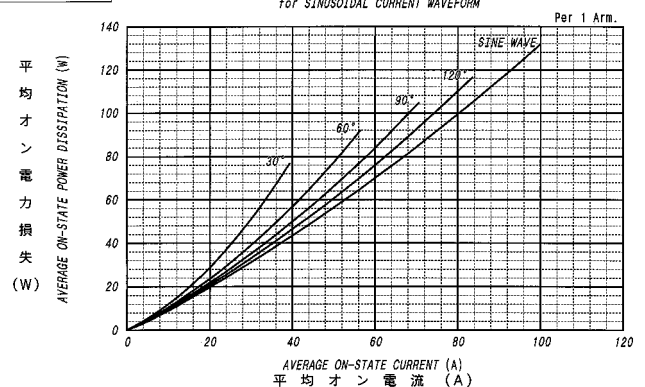
1 アーム当りの値 Value Per 1 Arm.

■定格・特性曲線

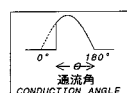
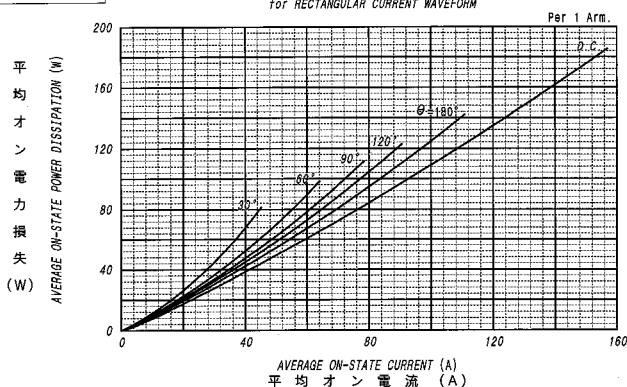
オン電圧特性
ON-STATE CURRENT VS. VOLTAGE



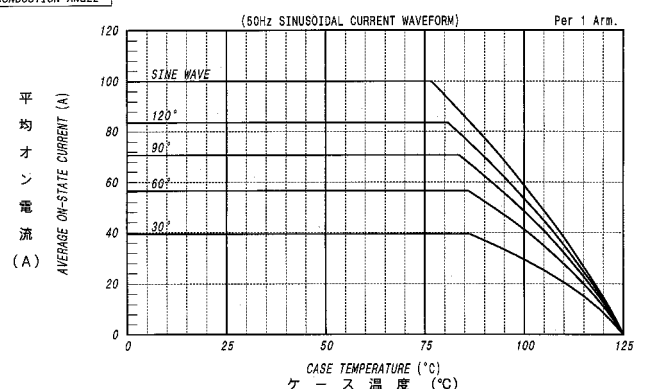
平均オン電力損失特性
AVERAGE ON-STATE POWER DISSIPATION
for SINUSOIDAL CURRENT WAVEFORM

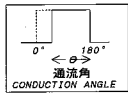


平均オン電力損失特性
AVERAGE ON-STATE POWER DISSIPATION
for RECTANGULAR CURRENT WAVEFORM

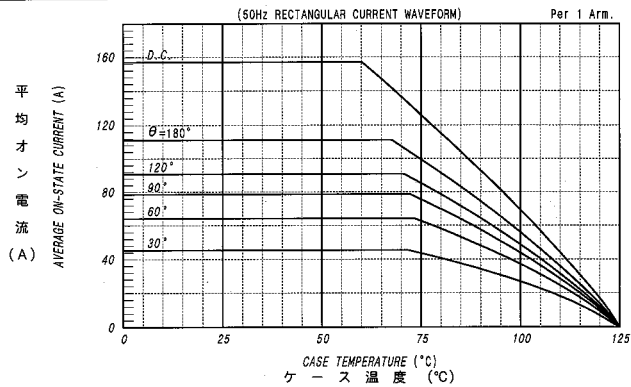


平均オン電流-ケース温度定格
AVERAGE ON-STATE CURRENT VS. CASE TEMPERATURE

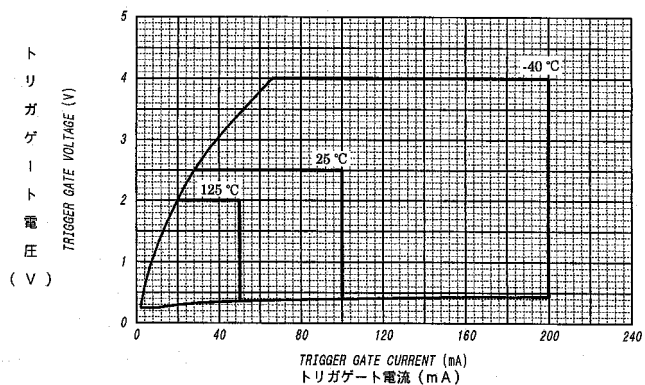




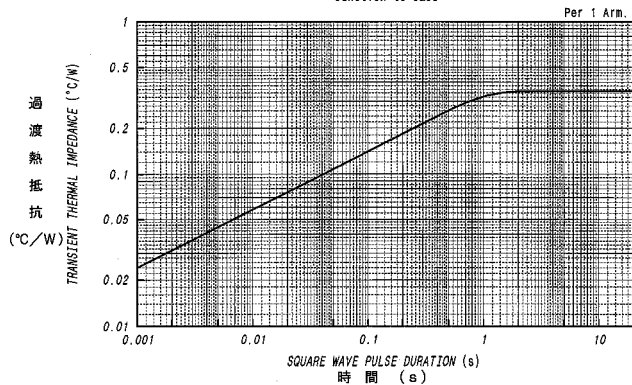
平均オン電流－ケース温度定格
AVERAGE ON-STATE CURRENT VS. CASE TEMPERATURE



ゲート特性
GATE CHARACTERISTICS

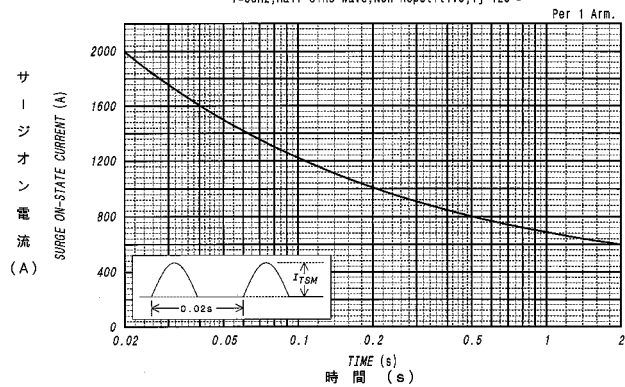


過渡熱抵抗特性
MAXIMUM TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE
Junction to Case



サージオン電流定格
SURGE CURRENT RATINGS

$f=50\text{Hz}$, Half Sine Wave, Non-Repetitive, $T_j=125^\circ\text{C}$



ゲート定格
GATE RATINGS

